임정태*, 김진모, 이인규, 이찬혁, 김철성 국민대학교 물리학과

1. 서 론

정보통신기술이 발전함에 따라 고주파대역에서 사용되는 소자의 개발이 요구되고 있다. 그러나 일반적인 소자로 이용되는 spinel ferrite는 Snoek의 한계에 의해 고주파대역에서 응용이 불가능하여, 대체소자로서 Y-type hexa-ferrite가 많은 관심을 받고 있다. Y-type hexa-ferrite는 면자기이방성과 spinel ferrite보다 높은 cut-off frequency의 특성을 갖고 있어, 고주파대역에서 우수한 자기적 성질을 가지고 있다[1]. 최근에는 수많은 연구원들은 높은 투자율(μ)을 가지고, 자기적 손실이 적은 물질을 발현시키기 위해 Y-type Barium-ferrite Ba₂Me₂Fe₁₂O₂₂ (Me=Co,Mg,Zn) 물질의 Me자리에 다양한 metal을 치환하여 자기적 특성을 연구하고 있다[2].

본 연구에서는 Co₂Y-type Barium-ferrite 물질의 Co자리에 미량의 Mg를 치환하여 결정구조 및 자기적 특성 을 연구하였다.

2. 실험방법

Ba₂Mg₀₅Co₁₅Fe₁₂O₂₂ 조성의 다결정 분말 시료는 직접합성법(soild-state reaction method)으로 제조하였다. 순 도 99.99% 이상을 갖는 Ba₂CO₃, Fe₂O₃, CoO, MgO 을 사용하여 마노에서 1시간 동안 혼합 후, 1000℃에서 10시간 동안 하소를 하였다. 1차 하소로 제조된 시료를 1050℃에서 10시간 동안 1차 열처리를 하였고, 1100℃ 에서 2차열처리를 하여 최종적으로 단일상의 Y-type Barium-ferrite를 합성하였다. 이렇게 제조된 Mg가 미량 치환된 Y-type Barium-ferrite의 결정성을 확인하기 위하여 Cu-Kα를 사용하는 Philips사의 X'Pert(3170) X-선 회 절 실험(XRD)을 하였고 결정학적 특성을 Rietveld 방법으로 분석하였다. 입자의 크기와 형태를 확인하기위해 전개방출형주사현미경(FE-SEM)으로 측정 하였다. 거시적인 자성특성을 측정하기위해서 진동시료 자화율 측 정 장치(VSM)를 이용하여 저온(50 K)부터 고온(750 K) 온도에 따른 자화율을 측정하였다. 미시적인 자성특성 을 확인하기 위하여 뫼스바우어 분광기를 통해 극저온(4.2 K)부터 상온(300 K)까지 측정을 하였으며, 뫼스바우 어 분석을 통하여 철 이온 간의 초미세상호작용 및 Fe, Co, Mg 이온의 부격자 점유 상태를 확인하였다.

3. 실험결과 및 고찰

직접합성법으로 제조된 BBa₂Mg_{0.5}Co_{1.5}Fe₁₂O₂₂ 샘플을 Rietveld 방법에 의한 Fullprof 컴퓨터 분석프로그램을 이용하여 XRD 분석을 하였으며, 분석 결과 RB와 RF은 4.90%와 3.57% 으로 단일상임을 확인하였고, R3m의 공간군을 가지는 Hexagonal구조이며, 격자상수는 a0 = 5.8696 Å, c0 = 43.5347 Å이었다. 또한, FE-SEM 측정 으로부터 입자의 크기가 3 µm의 판상구조임 확인하였다. VSM 측정결과 상온에서의 초투자율(µ₀)과 최대투자 율(µ_{max})은 각각 1과 1.287의 값을 보였고, 보자력(*H_c*)은 255.4 Oe이며, 포화 자화(*M_s*)는 28.0 emu/g(at 1 Tesla)로 측정되었다. 그리고 온도에 따른 자화율(ZFC, FC at 100 Oe)을 측정한 결과 589 K 부근에서 준강자성에서 상 자성으로 상전이가 나타냄을 확인하였다. 뫼스바우어 측정 결과 상온(300 K)에서 6개의 부격자 중 3aIV의 초 미세자기장의 세기(*H_h*)가 467 KOe이었으며, 이성질체 이동치(δ)가 0.198 mm/s로 분석되었다.



Fig 1. Refined x-ray diffraction patterns of the $Ba_2Mg_{0.5}Co_{1.5}Fe_{12}O_{22}$ at 300 K.



Fig 2. Magnetization curve of the $Ba_2Mg_{0.5}Co_{1.5}Fe_{12}O_{22} \mbox{ at } 300\mbox{ K}$

참고문헌

[1] J. W. Wang, A. L. Geiler, V. G. Harris, and C. Vittoria, J. Appl. Phys. 107, 09A515(2010)

[2] Z. W. Li, L. Guoqing, N.-L. Di, Z.-H. Cheng and C. K. Ong, Phys. Rev. B 72, 104420(2005)